

### 描述

HL8930Y是一款高压降压开关稳压器,可向负载提供高达3A的连续电流,它集成了一个4.5A限流的高侧、高压、功率MOSFET。6V至60V的宽输入范围适用于各种降压应用,使其成为汽车、工业和照明应用的理想选择。滞后电压模式控制便于极快速的响应,专有的反馈控制方案最大限度地减少了外围元件数量开关频率可高达1MHz。热关断和短路保护(SCP)提供可靠和容错操作。300 $\mu$ A的静态电流允许HL8930Y用于电池供电的应用最高可达90%的工作效率。

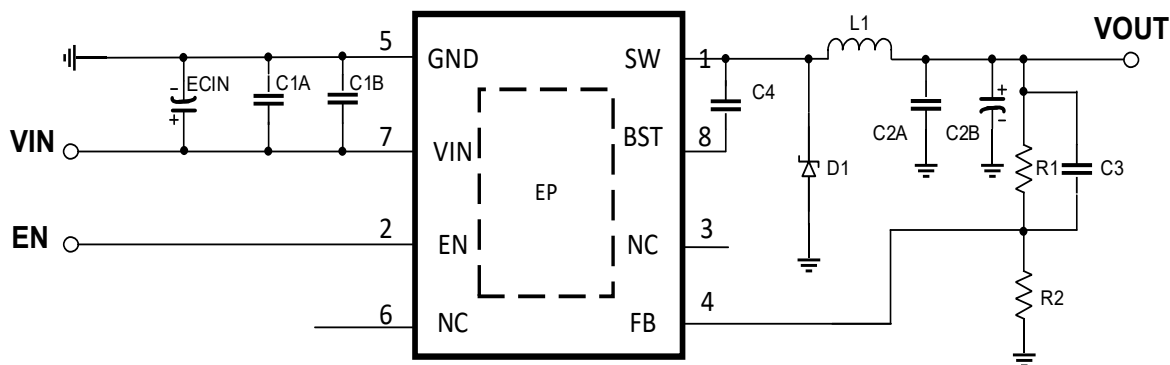
### 特性

- ❖ 6至60V输入电压范围
- ❖ 4.5A 典型峰值限流
- ❖ 3A 持续电流
- ❖ 滞后控制: 无补偿
- ❖ 可达1MHz的工作频率
- ❖ 集成高侧MOS管带短路保护
- ❖ 300 $\mu$ A 静态电流
- ❖ 过热保护
- ❖ 采用带散热片的ESOP8封装

### 典型应用

- ❖ 小电摩, 电动自行车, 控制电源
- ❖ 太阳能系统
- ❖ GPS 定位器
- ❖ 汽车系统电源
- ❖ 工业电源
- ❖ 大功率LED驱动器

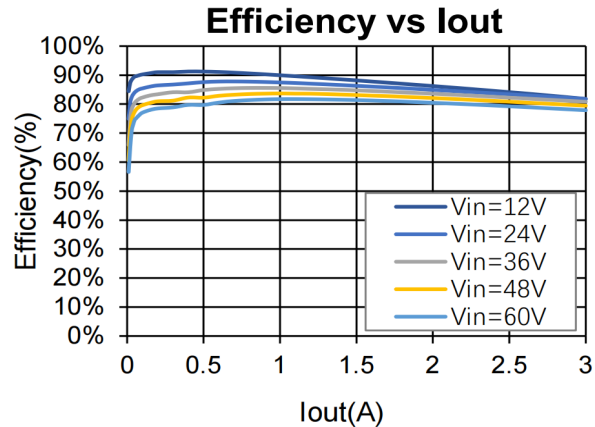
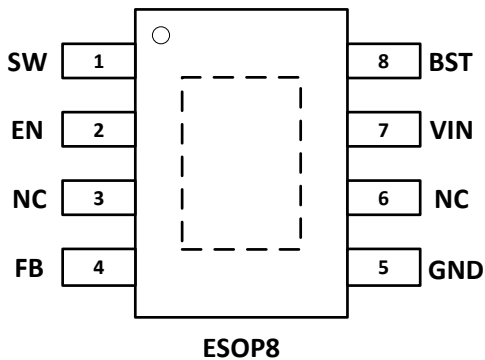
### 典型电路



## 订购信息

| 器件型号    | 型号全称      | 封装形式  | 环境温度         | 丝印标记    | 包装形式 | 包装数量   |
|---------|-----------|-------|--------------|---------|------|--------|
| HL8930Y | HL8930YEP | ESOP8 | -40℃ to +85℃ | HL8930Y | 卷带/盘 | 3000/盘 |

## 引脚信息



## 引脚描述

| 引脚  | 名称  | 引脚功能描述                                                         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1   | SW  | 开关节点。SW是高压侧开关的输出。需要一个低正向电压肖特基整流器接地。整流器必须放置在靠近SW的位置，以减少开关尖峰。    |
| 2   | EN  | 使能输入。将EN降至指定阈值以下以关闭HL8930Y；将EN抬至指定阈值以上来启动HL8930Y。              |
| 3,6 | NC  | 无连接。                                                           |
| 4   | FB  | 反馈脚。FB是电压滞后比较器的输入端。通过回路调节，平均FB电压保持在200mV。                      |
| 5   | GND | 接地端。GND应尽可能靠近输出电容器回路放置，以避免大电流开关路径。将裸露的焊盘连接到GND平面，以获得最佳的散热性能。   |
| 7   | VIN | 输入源。VIN为所有内部控制电路、BST调节器和高压侧开关供电。必须在VIN就近放置一个对地去耦电容器，以尽量减少开关尖峰。 |
| 8   | BST | 自举端。为高侧MOSFET驱动器栅极提供电源。在BST和SW之间连接一个旁路电容器。                     |
|     | EP  | 衬底散热片外漏封装。无内部电气连接。将EP焊接到GND引脚，并连接到覆铜平面以降低热阻。                   |

### 绝对最大额定范围

| 描述           |                | 范围         | 单位 |
|--------------|----------------|------------|----|
| 电源电压 (VIN)   |                | -0.3~66    | V  |
| 开关节点电压       |                | -1~VIN+0.6 | V  |
| BST 到 SW 电压差 |                | -0.3~6     | V  |
| 其它脚位         |                | -0.3~6     | V  |
| 存储温度范围       |                | -40~150    | °C |
| 结温           |                | 150        | °C |
| 导线温度         |                | 260        | °C |
| 静电释放 (ESD)   | HBM ( 人体模式 )   | ±2000      | V  |
|              | CDM ( 充电设备模式 ) | ±500       | V  |

### 热损耗信息

| 描述                      | 范围 | 单位   |
|-------------------------|----|------|
| 封装结温热阻( $\theta_{JA}$ ) | 50 | °C/W |
| 封装壳温热阻( $\theta_{JC}$ ) | 10 | °C/W |

### 推荐工作条件

| 描述     | 范围        | 单位  |
|--------|-----------|-----|
| 工作结温   | -40 ~ 125 | °C  |
| 工作环温   | -40 ~ 85  | °C  |
| 输入电压   | 6 ~ 60    | V   |
| EN电压   | 0 ~ 5     | V   |
| 最大开关频率 | 1         | MHz |

## 电气特性

VIN = 36V, TA = +25°C, 除非特别说明。

| 参数                       | 符号                        | 测试条件                                                                                         | 最小值  | 典型值  | 最大值 | 单位 |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----|
| 输入启动阈值                   | V <sub>UVLO</sub>         | V <sub>out</sub> =3.3V, Load=10mA                                                            |      | 4.7  |     | V  |
| 输入迟滞                     | V <sub>UVLO</sub><br>—hys | V <sub>out</sub> =3.3V, Load=10mA                                                            |      | 0.2  |     | V  |
| 关断电流                     | I <sub>SD</sub>           | V <sub>EN</sub> = 0V                                                                         |      | 5    | 8   | uA |
| 静态电流                     | I <sub>Q</sub>            | No load, V <sub>FB</sub> = 250mV                                                             |      | 300  |     | uA |
| 上MOS管导通电阻 <sup>(1)</sup> | R <sub>DS(ON)</sub>       | V <sub>BST</sub> - V <sub>SW</sub> = 5V                                                      |      | 210  |     | mΩ |
| 上MOS管漏电流                 | I <sub>SWLK</sub>         | V <sub>EN</sub> = 0V, V <sub>SW</sub> = 0V                                                   |      | 0.01 | 1   | uA |
| 限流                       | I <sub>PK</sub>           | V <sub>FB</sub> = 0.15V                                                                      | 4.2  | 4.5  | 4.8 | A  |
| EN开启阈值                   | V <sub>ENH</sub>          |                                                                                              | 1.4  | 1.6  | 1.7 | V  |
| EN迟滞                     | V <sub>ENHYS</sub>        |                                                                                              |      | 350  |     | mV |
| EN输入电流                   | I <sub>ENI</sub>          | V <sub>EN</sub> = 5V                                                                         |      | 0.01 | 1   | uA |
| EN上拉电流                   | I <sub>ENS</sub>          |                                                                                              |      | 0.25 |     | uA |
| 反馈电压                     | V <sub>FB</sub>           |                                                                                              | 195  | 200  | 205 | mV |
| 反馈电压高阈值 <sup>(2)</sup>   | V <sub>FBH</sub>          | 4.5V < V <sub>IN</sub> < 60V, V <sub>FB</sub> rising from 0V until V <sub>SW</sub> < 30V     | 209  | 215  | 221 | mV |
| 反馈电压低阈值 <sup>(2)</sup>   | V <sub>FBL</sub>          | 4.5V < V <sub>IN</sub> < 60V, V <sub>FB</sub> falling from 0.25V until V <sub>SW</sub> > 30V | 179  | 185  | 191 | mV |
| FB输入电流                   | I <sub>FB</sub>           | V <sub>FB</sub> = 5V or 0V                                                                   | -300 |      | 300 | nA |
| FB到输出开启延时 <sup>(2)</sup> | T <sub>FBDH</sub>         | Falling edge of V <sub>FB</sub> from 0.25V to 0V to V <sub>SW</sub> rising edge              |      | 100  |     | nS |
| FB到输出关断延时 <sup>(2)</sup> | T <sub>FBDL</sub>         | Rising edge of V <sub>FB</sub> from 0V to 0.25V to V <sub>SW</sub> falling edge              |      | 100  |     | nS |
| 热关断 <sup>(2)</sup>       |                           | Trigger thermal shutdown                                                                     |      | 150  |     | °C |
|                          |                           | Hysteresis                                                                                   |      | 20   |     | °C |

# 功能框图

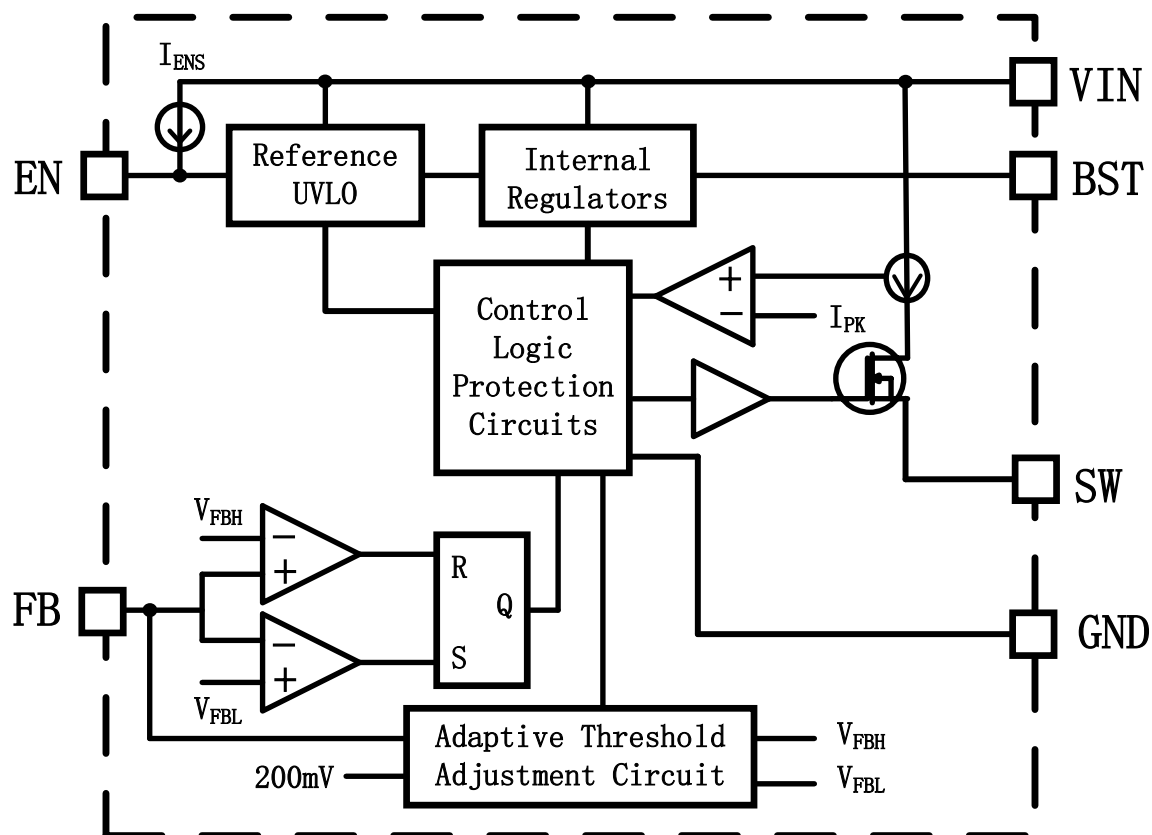


图 1: 功能框图

## 功能描述

### 自动阈值调节的滞环电流控制

HL8930Y在迟滞电压控制模式下工作，以调节输出电压。FB连接到电阻分压端上，该分压器决定输出电压。当FB电压（VFB）降至185mV时，功率MOSFET导通，并保持导通状态，直到VFB升至215mV。当VFB上升到215mV时，功率MOSFET关闭，并保持关闭状态，直到VFB降至185mV。215mV和185mV这两个阈值被自适应地调整，以补偿所有电路延迟，因此输出电压在FB时的平均值为200mV。

### 使能(EN) 控制

HL8930Y有一个带正逻辑的专用使能控制引脚(EN)。其下降阈值为1.3V，上升阈值为 1.65V（高出350mV）。EN 禁止悬空应用，如无需使用 EN，将其连接至固定电平。

### 浮空驱动器和自举充电

浮空功率MOSFET驱动器由外部自举电容器供电。该驱动器具有自己的欠压锁定（UVLO）保护。UVLO上升阈值为2.2V，阈值为150mV。自举电容由专用的内部自举稳压器充电并调节至约5V。如果内部电路没有足够的电压，并且自举电容没有充分充电，则可以使用额外的外部电路来确保自举电压处于正常工作区。有关更多详细信息，请参阅第8页的外部自举二极管部分。

### 欠压锁定 (UVLO)

欠压锁定（UVLO）以保护芯片在电源电压不足的情况下运行。UVLO的上升阈值约为4.7V，而其下降阈值始终为4.5V。

### 热关断

热关断用以防止芯片在极高温下运行。当硅管芯温度高于其上限阈值时，整个芯片会关闭。当温度低于其下限阈值时，芯片再次启用。

### 输出短路保护

当VFB在200mV左右时，输出电压得到很好的调节。如果输出在过电流保护（OCP）中被拉低或直接短路到GND，即使功率MOSFET导通，VFB也会低。HL8930Y将低VFB视为故障。

如果故障时间超过10μs，功率MOSFET将关闭。HL8930Y在延迟约300μs后再次尝试运行。功率MOSFET电流也通过电流感测MOSFET精确感测。如果电流超过限流，IC将关闭。这在输出短路条件下提供了额外的保护。

## 应用信息

### 输出电压配置

输出电压（ $V_{OUT}$ ）由电阻分压（ $R1$ 和 $R2$ ）设置（见第1页的典型应用）。为了实现良好的抗噪性和低功耗，建议 $R2$ 在 $5k\Omega$ 至 $50k$ 的范围内。然后可以用方程式（1）确定 $R1$ ：

$$R1 = \frac{V_{OUT} - V_{FB}}{V_{FB}} \times R2$$

### 输出电容和频率设置

输出电容（ $C_{OUT}$ ）必须实现平滑的输出电压。相比电容值，电容的ESR应足够大；否则，系统可能会以非预期的状态运行，电流纹波可能非常高。当功率MOSFET开启时， $V_{FB}$ 从 $185mV$ 变为 $215mV$ 。为了给电容充电并在 $FB$ 产生 $215mV$ ，系统需要ESR和一些电感电流。例如，对于 $5V$   $V_{OUT}$ ，如果正向电容为 $0.1\mu F$ ，则输出电容建议用ESR范围为 $100m\Omega$ 至 $250m\Omega$ 的铝电解电容，再并接小容值的陶瓷电容。

当输出电容为铝电解电容时，通过 $R1$ 连接到此极性电容正，如果输出电容和ESR不改变，则可以设置所需的频率。极性电容可以降低输出电压纹波。

在某些应用中，简单的极性电容可能无法获得适当的频率，那么我们可以在极性电容上串联一个电阻，甚至在输出端并联一个陶瓷电容。

### 电感选择

电感（ $L$ ）需要将开关电压转换为到负载的平滑电流。虽然输出电流较低，但建议电感电流在每个开关周期内保持连续，以防止达到限流。用方程式（2）计算电感值：

$$L = \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{F_{SW} \times I_{OUT} \times V_{IN} \times K}$$

$K$ 是一个系数，约  $0.15 \sim 0.85$ 。

### 输出续流二极管

当高侧MOS关闭时，输出续流二极管向电感流过电流。为了减少由于二极管正向电压和恢复时间造成的损耗，请使用肖特基二极管。

通过二极管的平均电流可以用方程式（3）近似表示：

$$I_D = I_{OUT} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)$$

需选用最大反向电压大于最大输入电压，电流额定值大于平均电流的二极管。

### 输入电容(CIN)

降压转换器的输入电流是不连续的, 因此为保持直流输入电压, 需要一个电容向降压转换器提供交流电流。选用低ESR的电容可获得最佳性能, 特别是在高开关频率应用中。

通过输入电容的RMS电流可以用方程式 (4) 计算:

$$I_{IN\_AC} = I_{OUT} \sqrt{\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)}$$

对于低ESR电容器, 输入电压纹波可以用方程式 (5) 估算:

$$\Delta V_{IN} = \frac{I_{OUT} \times V_{OUT}}{F_{SW} \times C_{IN} \times V_{IN}} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)$$

选择一个具有足够RMS额定电流和足够容值的输入电容, 以获得较小的输入电压纹波。

当使用铝电解或钽电容时, 应将一小型、高质量的陶瓷电容 (约0.1μF) 尽量靠近IC放置。

### 外部自举二极管

外部自举二极管可以提高转换器的效率 (见图2)。在以下情况下, 建议从5V电源到BST使用外部BST二极管:

- 电路板系统有一个 5V 电源路径
- 输入不大于 5V
- 输出在 3.3V~5V 间

此二极管也建议用于高占空比工作 (当 $V_{OUT}/V_{IN} > 65\%$ 时) 和极高频 (接近1MHz) 的应用。

自举二极管可以选低成本的如IN4148或BAT54。

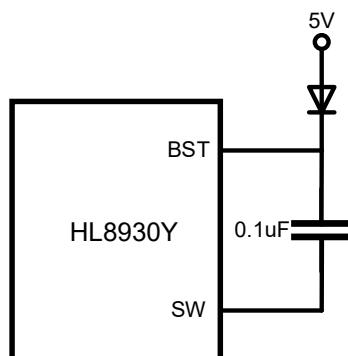


图2: 外部自举二极管

## PCB 布局指南

高效的PCB布局对于电路稳定运行至关重要。为了获得最佳性能，请遵循以下指南。

1. 将输入去耦电容、续流二极管和 HL8930Y 的 (VIN、SW 和 PGND) 尽量靠近放置。
2. 保持电源线径尽量短而宽，特别是对于 SW 节点。这可以帮助大大减少 SW 节点上的电压尖峰，降低 EMI 噪声等级。
3. 反馈路径尽可能远离电感和功率路径（如 SW 节点）。
4. 在裸露的焊盘下方放置直径为 15mil、间距为 40mil（中心之间的距离）的散热通孔，以改善热传导。
5. EN 禁止悬空应用，如无需使用 EN，将其连接至固定电平。
6. 采用 T0252 封装的肖特基二极管(MBR20100DT)使重载散热增强而提高负载。

## 典型应用电路

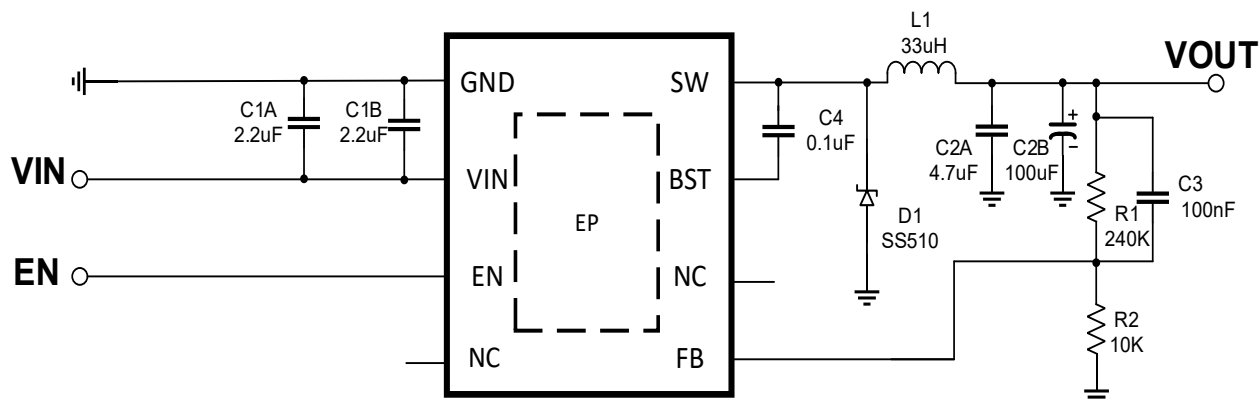


图9: 肖特基=5A/100V,  $V_{in}=15\sim60V$ ,  $V_{out}=5V$ ,  $I_{OUT}=0\sim3A$

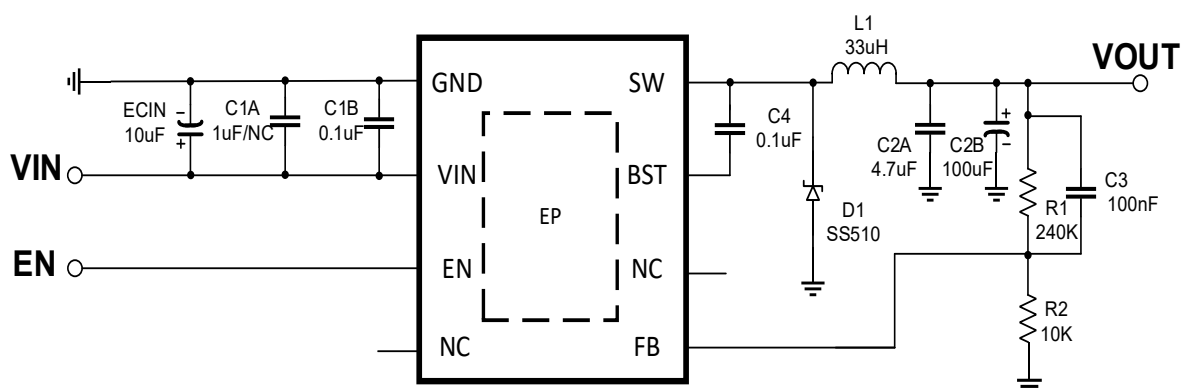


图10: 肖特基=5A/100V,  $V_{in}=6\sim60V$ ,  $V_{out}=5V$ ,  $I_{OUT}=0\sim3A$

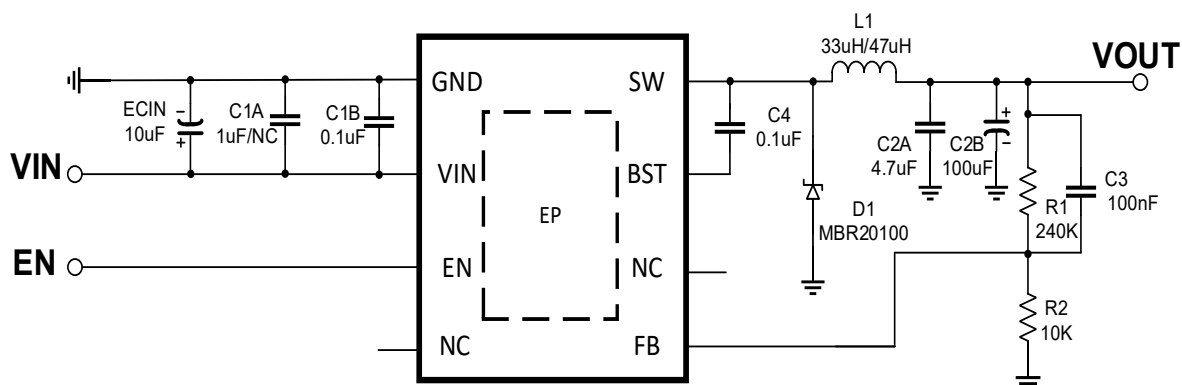
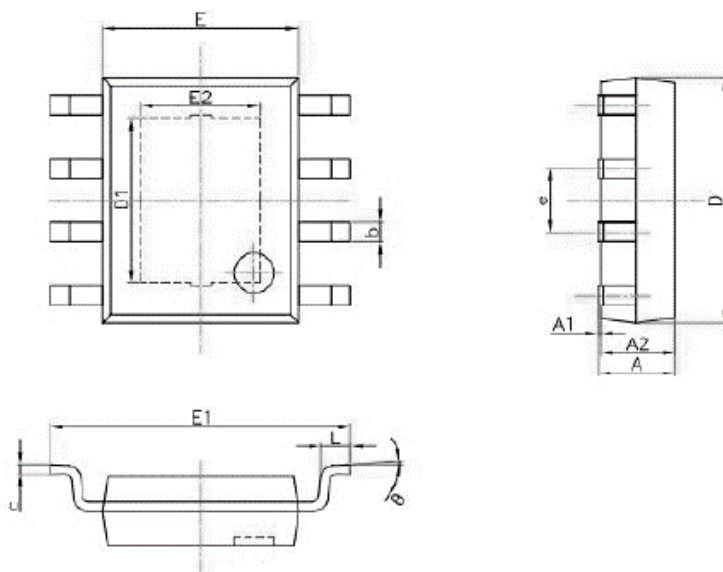


图11: 肖特基=20A/100V,  $V_{in}=6\sim60V$ ,  $V_{out}=5V$ ,  $I_{OUT}=0\sim3.5A$

## 封装描述

### ESOP8

ESOP-8L



| Symbol | Dimensions In Millimeters |       | Dimensions In Inches |       |
|--------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
|        | Min.                      | Max.  | Min.                 | Max.  |
| A      | 1.300                     | 1.700 | 0.051                | 0.067 |
| A1     | 0.000                     | 0.100 | 0.000                | 0.004 |
| A2     | 1.350                     | 1.550 | 0.053                | 0.061 |
| b      | 0.330                     | 0.510 | 0.013                | 0.020 |
| c      | 0.170                     | 0.250 | 0.007                | 0.010 |
| D      | 4.700                     | 5.100 | 0.185                | 0.201 |
| D1     | 3.202                     | 3.402 | 0.126                | 0.134 |
| E      | 3.800                     | 4.000 | 0.150                | 0.157 |
| E1     | 5.800                     | 6.200 | 0.228                | 0.244 |
| E2     | 2.313                     | 2.513 | 0.091                | 0.099 |
| e      | 1.270(BSC)                |       | 0.050(BSC)           |       |
| L      | 0.400                     | 1.270 | 0.016                | 0.050 |
| θ      | 0°                        | 8°    | 0°                   | 8°    |

### 静电防护提示

如果不遵守正确的ESD处理措施和安装防护程序可能会损坏器件。  
ESD损坏的范围可能从轻微的性能下降到整个IC故障。复杂的IC可能更容易损坏  
因为即使细微的参数变化也会导致IC与其发布的规格不一致。